Status of SCSS Prototype Accelerator and XFEL Project in Japan

Tsumoru Shintake^{1,A)}, Takao Asaka^{B)}, Yoshihiro Asano^{A,B)}, Hitoshi Baba^{A)}, Teruhiko Bizen^{B)}, Hiroyasu Ego^{B)}, Toru Fukui^{B)}, Shunji Goto^{B)}, Hirohumi Hanaki^{B)}, Toru Hara^{A,B)}, Atsushi Higashiya^{A)}, Toko Hirono^{A,B)}, Naoyasu Hosoda^{B)}, Takahiro Inagaki^{A)}, Shinobu Inoue^{B)}, Miho Ishii^{A,B)}, Yasuhide Ishizawa^{B)}, Daisuke Iwaki^{A)}, Koujiro Kase^{A)}, Yoshitaka Kawashima^{B)}, Hiroaki Kimura^{A,B)}, Tomoyuki Kirimura^{A)}, Masanobu Kitamura^{A)}, Satoru Kojima^A, Hirokazu Maesaka^{A)}, Xavier Marechal^{B)}, Sakuo Matsui^{B)}, Hiroshi Matsumoto^{B,C)}, Tomohiro Matsushita ^{A,B)}, Tetsuro Mochizuki ^{B)}, Jong-Seok Oh^{A,D)}, Haruhiko Ohashi ^{B)}, Toru Ohata ^{A,B)}, Takashi Ohshima^{B)}, Kazuyuki Onoe^{A)}, Yuji Otake^{A)}, Tatsuyuki Sakurai^{A)}, Takamitsu Seike^{B)}, Yoshihiro Sekiguchi^{A)}, Katsutoshi Shirasawa^{A)}, Shinsuke Suzuki^{B)}, Kazuhiko Tahara^{A)}, Tetsuya Takagi^{B)}, Sunao Takahashi^{B)}, Takeo Takashima^{B)}, Masao Takeuchi^{B)}, Hitoshi Tanaka^{A,B)}, Ryotaro Tanaka^{A,B)}, Takashi Tanaka^{A,B)}, Yoshihito Tanaka^{A)}, Shingo Taniguchi^{A,B)}, Takanori Tanikawa^{A)}, Kazuaki Togawa^{A)}, Rieko Tsuru^{A)}, Shukui Wu^{B)}, Makina Yabashi^{A,B)}, Akihiro Yamashita^{B)}, Kenichi Yanagida^{B)}, Chao Zhang^{B)}, Noritaka Kumagai^{A,B)}, Tetsuya Ishikawa^{A,B)}, Hideo Kitamura^{A,B)} ^{A)} RIKEN/SPring-8, 1-1-1, Kouto, Sayo, Hyogo, 679-5148 ^{B)} JASRI/SPring-8, 1-1-1, Kouto, Sayo, Hyogo, 679-5198 ^{C)} KEK, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801 ^{D)}PAL/POSTECH, Pohang, Korea

Abstract

On 20 June 2006, the SASE amplification has been observed at 49 nm in SCSS test accelerator, which is prototype for the Japanese XFEL. A challenging approach: CeB_6 single crystal thermionic cathode generates low emittance DC beam from 500 kV gun, followed by velocity bunch compression by factor of a few 100 times, and magnetic chicane bunch compression, measured emittance was 3 π .mm.mrad normalized, made SASE amplification. The XFEL project, aiming at generating 1 Å coherent intense X-ray laser, 8 GeV normal-conducting accelerator, has been funded. The construction is scheduled 2006-2010.

SCSS試験加速器の現状、ならびにX線自由電子レーザー計画について

1. はじめに

波長1Å領域のコヒーレント光源を目指すX線 自由電子レーザー(XFEL)計画の加速器技術 [1]を総合試験するため、SPring-8地区に建設を進 めていたSCSS試験加速器において、2006年6月 20日、真空紫外線領域においてSASE-FELのレー ザー増幅を確認した。これによって、低エミッタ ンス電子入射器、Cバンド加速器、アンジュレー タの技術的評価を行うことができ、実機XFEL の設計、建設に技術的な裏づけを得た。

オングストローム領域にて SASE-FELを実現する ためには、まずは低エミッタンスの電子源が必須 であり、つぎにこれをエミッタンスを壊さずにバ ンチ圧縮して所定のピーク電流に押し上げるシス テム設計が必要である。すなわち、最終的に1 π . mm. mradという低エミッタンス(スライス値)、 ピーク電流 3000 A、輝度 3000 A/ π . mm. mrad とい う電子ビーム量が要求されるのである。

さてこのシステムの実証実験を行う場合の最大の問題は、その測定方法である。SASE-FELの増幅 ゲインを決定するスライスエミッタンスは 1 π .mm.mrad以下、エネルギー分散は 1 x 10⁻⁴以下が 要求されており、両者を正確に測定することは、 事実上不可能に近い。

そこで、電子ビームをアンジュレータに通して レーザー増幅を行い、増幅率の測定等から逆に電 子ビームのパラメータを評価する方が、総合評価 となり、はるかに安全性が高くなる。レーザー増 幅そのものが電子ビームの測定実験なのである。

2. 試験加速器の構成と建設

試験加速器の構成は次のように決定した。

(1) 電子入射器は出来るだけ、実機XFELと同
一の構成とした。ただし、L-band のバン

¹ E-mail: shintake@spring8.or.jp



図1. SCSS試験加速器。ビームエネルギー250 MeVにて波長49 nmのSASE増幅に成功 した。手前から 500 kV パルス熱電子銃、238 MHzサブハーモニックバンチャー、 476 MHzブースター、S-band APSバンチャー、S-band 進行波加速管、50 MeVダンプ、Cバン ド加速部、アンジュレータと続いている。トンネル全長 60 m。地上施設、左の壁の外に 電源、制御、コントロール卓があり、アクセスが容易。

チャー加速部は、必要な 20 MWクラスのパル スクライストロンが建設期間内に入手不可と わかり、Sバンドにて実施したため、位相空 間のアクセプタンスが8分の1となっており、 予想されるビーム輝度はそれに比例して低い。 実機ではLバンドとする。

- (2) ビームエネルギーが高い方が、発振波長 が短く利用研究の幅が広くなる。しかし建屋 の長さ、建設コスト等の検討により、250 MeV、波長 60 nmとした。
- (3) アンジュレータの台数は、数値計算による電子ビームエミッタンスとピーク電流から 飽和に届く2台とした。
- (4) 制御システムは、SPring-8にて構築され 運転実績のある MADOCAを採用し、出来るだ け現存する資産を活用した。

具体的な建設にあたり、少ない人員の中で、この複雑な加速器を短期間に建設するために、組織を「横割り」とした。すなわち、クライストロンのパルス電源を担当するスタッフは、電子銃、Sバンドバンチャー、Cバンド加速器のすべての電源を担当する、電力、真空、冷却水、制御、設置、アライメントも出来るだけ横並びとした。理研の3研究室とJASRIが加わったグループの中でこれを実施した。アンジュレータ以外のすべての決定権を

筆者に与えていただき、この組織編制はすばらし い成果をあげた。試験加速器の建設決定時点2004 年7月に、完成目標を1年半後の2005年10月末と した。そして予定通り10月末に完成し、そして 11月末には、アンジュレータ下流まで電子ビーム を運び、自然放射を確認した。

最初の立ち上げ試験で不具合のあった部分の手 直しと、不足分の設置を2006年3月末までに完了。 加速管のエージング、運転に必要なソフトの拡充 を経て、連休明けの5月8日よりレーザー増幅に向 けて本格的にビーム調整を開始した。

このビーム調整の詳しい解説は田中均が本会に 報告しているので、そちらを参照していただきた い[2]。

3. 電子入射器

我々のXFEL計画と、そのSCSS試験加速 器が、諸外国のプロジェクトと大きく異なってい るのは、電子源である。すなわち単結晶CeB₆の熱カ ソードを採用し、サブハーモニックバンチャー、 バンチャーの古典的な入射器の構成をとっている ことである。この方針を取ったのは、古典的な構 成の入射器を丁寧に見直せば、必ずや最適解が存 在するだろうという予感があったためである。

熱電子銃を用いた場合の最大のメリットの一つ

が、メインテナンスフリーという事であって、こ れは「仕事が減るからいい」という意味ではなく、 メインテナンスしないでも一定の性能が確保でき るという意味。これによって、常に同じ特性の電 子ビームが加速器に供給されるので、日々の運転 でのパラメータの再現性が良いということである。 X線FELでは、これが特に重要であって、アン ジュレータ区間のビーム軌道のチューニングにミ クロンメートルの精度が要求され、また長さ100m にも及ぶアンジュレータ区間をすべてチューニン グする必要があるために、上流のビームパラメー タに変動や変更があっては調整が全く成り立たな いのである。

さて具体的な設計を振り返ると

- (1) 必要なビーム電流を供給するカソードとしてLaB₆またはCeB₆のカソードがあり、電子顕微鏡の電子源としてマーケットが確立しており、高純度の単結晶が入手可能であった[3]。ただし、ニードル型ではなく、結晶をフラットにカットし、面源として1A以上の電流を取り出している。CeB6の方がLaB6より、約2倍寿命が長いとの報告があり、CeB6を採用した。ただし、1600度Cを超える運転では、LaB6の方が、寿命が長くなるので注意が必要。
- カソードの温度と面積から算出される理 論熱エミッタンスが 0.4 π.mm.mradであり十分 に低い値とわかった。ただし面密度は30 A/cm² 以上となる。
- (3) 面密度 30 A/cm2の電流を温度制限領域と するには 約 400 kV/5cm以上の電圧が必要。
- (4) 一方、サブハーモニックバンチャーから バンチャー空胴へのビーム輸送において、空間 電荷効果によってビーム が受ける発散力は左式に よっており、明らかに初 期エネルギーが高い方が良い。
- (5) 電子銃に印加できる電圧は、クライスト ロンの最高電圧 500 kVから決定した。電子銃 の絶縁セラミックは現在までの運転で、幸い1 回も放電パンクしていない、すばらしい。
- (6) 500 kVはパルスでなければ、実用にならない。我々の電子銃はなぜか、「DC熱電子銃」と誤解されているが、実際は、数マイクロ秒のパルス高電圧による「pulse熱電子銃」である。高電圧パルスは、クライストロン・モジュレータ電源から昇圧トランスを通して供給している。またインピーダンスのマッチングには、ダイオード電子管を用いている[4]。
- (7) 短パルスの切り出しのため、通常の熱電 子銃では、グリッドを使用しているが、グリッ ドは明らかにエミッタンスを悪化させるので排 除した。
- (8) 1 nsecのビームパルスの切り出し。幸い、 JASRIの小林氏が電子銃のグリッドから出る暗 電流をカットするためのビームデフレクターを 開発中であり、1 nsec程度の切り出しに成功し

ていたのでこれを参考とした[5]。パルサーは イギリスのKenteck社製。バイアスコイルにて ビームを曲げ、下流のモリブデンターゲットに て止める。1 nsecのパルスを50オームの平行平 板に送り、ビームを曲げもどし、下流に送る。 エミッタンスを壊さないような電極の設計を渡 川君が詳細に行った[6]。

- (9) サブハーモニック・バンチャー空胴によって、電子ビームをバンチに形成する。その周波数をSバンドの12分の1に選定。固体素子の増幅器が入手できること、空胴の直径が極端に大きくならない範囲で選定した。この空胴とすぐ下流の476 MHzブースターが電子バンチのタイミングを決定するため、熱安定性、機械的安定性を重視し,空胴ノーズの中心軸をビームラインに正確にアライメントできる構造とした。詳細は柱野氏の報告を参照[7]。4台の固体増幅器の電力を合成する代わりに、加速空胴を合成器として使用しているのが、面白いアイデアである。
- (10) ブースター空胴。電子ビームが集群する につれてピーク電流が高くなり、空間電荷効果 によりビームが発散する。そこで、ブースター 空胴によってエネルギーを 1 MeV以上に上昇さ せ、相対論の効果によってビーム発散を抑える。 高周波源はIOT(Eimac製、70 kW パルス出力)。 空胴設計、製造については、柱野君の報告を参 照[8]。
- (11) 収束系。従来の入射器は、あの大きな多数のソレノイドコイルに取り囲まれていて、メインテナンスがやりにくかった。また調整が容易ではなかった。そこで電子顕微鏡等で使われている磁気レンズ(小さなソレノイドコイルと磁気ヨーク)を用い、レンズ→ドリフト→レンズ→空胴→レンズというように、要素を空間的に分離し、パラメータを個別に調整できるようにした。これはいわゆるリング加速器のcombined functionからseparated functionの進化に相当する。
- (12) S-band APS空胴。476 MHz空胴のあとドリ フト走行する間にVelocity bunching によって 電子バンチはさらに短くなり、いよいよ高電界 加速器空胴によって高エネルギー領域に持ち込 まれ、電子分布が相対論的効果によって固定さ れる(電子の見かけの質量が大きくなり外乱に 対して強くなること)。ここは出来るだけ周波 数が低いほうが良い。しかし大電力マイクロ波 が得られるのは、Lバンド以上の周波数。試験 加速器の建設当初に 20 MW程度のLバンドのク ライストロンが入手できないので、試験加速器 ではSバンドで代用することとした。空胴はA PS型の定在波。入力カプラ空胴を加速管の中 央にもってくることで、低エネルギーの電子が 入射する最上流の空胴では、対称性の良い電界 が得られ、非対称電磁場によるエミッタンス破 壊がない。APS空胴の製作の詳細は、稲垣君



図2. エミッタンス測定。 Qスキャン法によって、入射器出口でのエミッタンスを測定。

の報告を参照のこと[9]。

- (13) Sバンド進行波管、2mの KEK-B向けの 進行波管を使用している。これによって、電子 ビームエネルギーは 50 MeVまで加速され、 シュケイン磁場のバンチコンプレッサーに送ら れる。
- (14)シュケイン磁場型バンチコンプレッサー。 上流の2 m進行波管での電子ビームの位相を、 バンチング側、すなわち、バンチの頭が低エネ ルギー、テールが高エネルギーとなるように調 節し、シュケイン磁場を通してバンチ圧縮する。 基本設計では圧縮率2倍であるが、実際の運転 では大きく変動させて最適値を適宜選定した。 この詳細は、田中均、原徹の報告を参照 [2][10]。興味深いのは、現在までCSRinstabilityらしき現象が観測されていないこ とである。熱電子銃からの電子ビームが時間的 に滑らかで、振動源となる密度変調が混在して いないのかもしれない。
- (15) RF制御系は各クライストロン別に独立に 固体増幅器を有し、デジタルIQ変調、復調器 によって高度な制御を可能としている。またCbandのRFをタイミング同期に用いて、高精度 のタイミングシステムが構築されている[11]。 またこれには、Cavity-BPMの検出回路も含まれ ており、システムを簡素化している。

その他、試験加速器には数多くの新しい取り組 みがなされているので、本会の関係の報告を参照 されたい。

4. エミッタンス測定

入射器出口でのエミッタンスを測定した(図 2)。ビームダンプ直前のQ磁石の1台の配線を逆 転してFF配置とし、水平に強収束し、下流のO TRモニターにて幅を観測。Q磁石の強度を変化 させてエミッタンスを測定し、2.9 π.mm.mradとい う値を得た。ビーム電荷 0.25 nC、パルス幅 1 psec。数値シミュレーションとも良い一致を見た。 スライスエミッタンスの測定を 50 MeVダンプへ ビームを曲げて行い、y方向、2 π.mm.mradという 数値を得ているが、プロファイルモニターの分解 能に制限されている。実際の値は、1 π.mm.mrad以 下と思われるが測定、数値計算ともに困難が多い。

5. レーザー増幅実験

下流のアンジュレータのギャップを閉め、軌道 エラーをCavity-BPMにて修正し、下流においたス ペクトロメータによって、発光のスペクトルを観 測すると、SASE-FEL増幅によって、スペ クトルは非常に狭くなっていることが観測された (図3)。また電流量を変化させると図4のよう に非線形の変化を示し、0.2 nC付近からSASE増幅 が開始していることがわかった。この種のデータ からSASEゲインを決定し、ピーク電流とエミッタ



図3.最初に観測されたSASE増幅を示唆する アンジュレータ放射光のスペクトル。幅が狭く、 左右対称。ビームの電荷量を下げてゆくと、自 然放射となり、幅が広く長波長側の裾が長くな り通常のアンジュレータ放射に特有なスペクト ルとなる。(下の青色の広いカーブが自然放射、 見やすくするため500倍に拡大している)。



図4. 電荷量に対するFELピークパワー変化。2006年7月末までの調整で、飽和に近いデー タが得られている。

ンスの比(すなわちビーム輝度)を推定するとい う評価を田中均君が行っており、400 A/πmm.mrad という値が得られている[2]。また発生したFEL 光の特性測定を矢橋君が行っており[12]、図5のよ うにvisibilityの高い干渉縞が得られている。

6. 実機建設

試験加速器にてレーザー増幅に成功し、その データ解析により電子ビーム輝度が目標内である ことを確認し、低エミッタンス電子ビームの発生 技術が完成したことを意味しており、XFELの 実現が原理的に可能であることを示している。

しかし、試験加速器での運転によって、ハード ウエアにいくつかの不具合が発見されており、こ れらについて設計変更、デバック、運転試験を実 施しながら、実機の建設を行う必要がある。

クライストロンの数で80本近い加速器を新規に 建設するという、大型プロジェクトであります。 スケジュール等を注意深く見ながら、事故のない ように遂行し、必ずやX線FELを完成させたい と思っております。

7. 謝辞

これまでSCSSの技術開発、試験加速器の建 設に協力いただきましたメーカーの方々に感謝い たします。また昨年、春から秋にかけて不眠不休 の闘いで建設に係わっていただいた方々、そして、 この方々を背後から支えていただいたご家族の 方々にも、ここに深く感謝いたします。

また論文のリストにない事務方、秘書そしてア ルバイトの方々の見えない努力に深く感謝いたし ます。

皆さん、ほんとうにご苦労様、そして、ありがとうございました。



SASE (1 shot, bunching condition)



Spontaneous radiation (debunching condition, 100 shots)

図5. 2重スリットによる干渉試験。

(スリット幅 100 μm, 間隔 400 μm) 、SASE増 幅では、干渉性の高い波が得られている[12]。

参考文献

[1] T. Shintake, *et al.*, "Status of SCSS X-FEL project at RIKEN/SPring-8", Proc. of the 2nd Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and 30th Linear Accelerator Meeting in Japan, Tosu, 2005. [2] H. Tanaka, *et al.*, "Beam Performance of the SCSS Prototype Accelerator", this meeting.

[3] FEI Beam Technology.

http://www.feibeamtech.com/

[4] Diode tube matching method was suggested by H. Matsumoto.

[5] T. Kobayashi, *et al.*, "Development of the beam deflector", Proc. of the 25th Linear Accelerator Meeting in Japan, Himeji, July 12-14, 2000.

[6] K. Togawa, *et al.*, "Beam deflector system to generate a low-emittance short electron bunch", this meeting.

[7] T. Hashirano, *et al.*, "Development of the 238MHz Cavity for SASE-FEL", Proc. of the 2nd Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and the 30th Linear Accelerator Meeting in Japan(2005), pp340-342

[8] T. Hashirano, *et al.*, "Development of 476MHz Cavity for SASE-FEL", this meeting.

[9] T. Inagaki, *et al.*, "Construction and operation of S-band APS-type accelerating structure for SCSS injector", this meeting.

[10] T. Hara, *et al.*, "Comparison of PARMELA simulation and measured parameters on SCSS prototype accelerator", this meeting.

[11] Y. Otake, *et al.*, "Sub-pico-second Trigger and Phase Control for SCSS", this meeting.

[12] M. Yabashi, *et al.*, "VUV diagnostic system for SCSS Prototype Accelerator", this meeting.